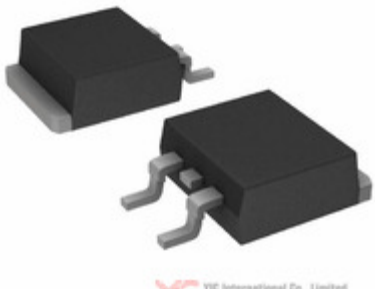




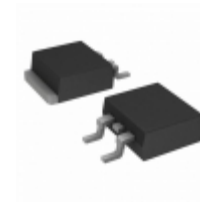




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB029N06N3GE8187ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB029N06N3GE8187ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB029N06N3GE8187ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 118µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	165nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB029N06N3GE8187ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB029N06N3GE8187ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB029N06N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB029N06N3GE8187ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB029N06N3G INFINEO IPB029N06N3G INFINEO</p>	 <p>IPB030N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB029N06N3 G Infineon Technologies IPB029N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB031N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>
 <p>IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON</p>	 <p>IPB031NE7N3G INF IPB031NE7N3G INF</p>	 <p>IPB031NE7N3 G INFINEON IPB031NE7N3 G INFINEON</p>	 <p>IPB029N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB029N06N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB029N06N3GE8187ATMA1 Datenblatt	IPB029N06N3GE8187ATMA1- Datenblätter	IPB029N06N3GE8187ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB029N06N3GE8187ATMA1
IPB029N06N3GE8187ATMA1 Electronic	IPB029N06N3GE8187ATMA1- Komponenten	IPB029N06N3GE8187ATMA1-Verteiler	IPB029N06N3GE8187ATMA1-Bild	IPB029N06N3GE8187ATMA1-Teil
IPB029N06N3GE8187ATMA1 Aktie	IPB029N06N3GE8187ATMA1 Inventar	IPB029N06N3GE8187ATMA1 Neu	IPB029N06N3GE8187ATMA1 Hersteller	IPB029N06N3GE8187ATMA1 Bild
IPB029N06N3GE8187ATMA1 RFQ	IPB029N06N3GE8187ATMA1 Online bestellen		IPB029N06N3GE8187ATMA1 Original	IPB029N06N3GE8187ATMA1 garantiert